

09/04/2015

ČTVRTEK



Polovodičové technologie pro výzkum a vývoj: difúzní a oxidační procesy, technologie LPCVD a MOCVD

zasedací místnost, 2. patro, budova A2,
Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2,
Brno

Pořádá výzkumná infrastruktura CEITEC Nano

Vážení kolegové a spolupracovníci,
dovolujeme si Vás pozvat na pracovní seminář uspořádaný v rámci zakázky na dodávku vysokoteplotních reaktorů od společnosti SVCS. Součástí semináře bude diskusní workshop pro optimalizaci designů jednotlivých reaktorů z hlediska plánovaných experimentů základního a aplikovaného výzkumu.

PROGRAM

- 13:50 – 14:00 Registrace účastníků semináře
- 14:00 – 14:05 Zahájení semináře (David Škoda)
- 14:05 – 14:20 Rekapitulace základních bodů zakázky na dodávku polovodičových technologií, požadavky na připravenost pracoviště při instalaci jednotlivých technologií – elektrické a plynové rozvody, rozvody chladicí vody, vzduchotechnika, rekuperace tepla, čisté prostory (Pavel Lukašík)
- 14:20 – 14:30 *Diskuse připravenosti pracoviště, předpokládané termíny*
- 14:30 – 14:50 Možnosti a specifika oxidačních procesů (suchý a mokrý oxid SiO₂) a procesů fosforové a borové difúze (Pavel Lukašík, Aleš Poruba)
- 14:50 – 15:10 Možnosti a specifika LPCVD procesů (SiN_x, SiO_xN_y, HTO, LTO) (Pavel Lukašík)
- 15:10 – 15:20 *Diskuse atmosférických polovodičových procesů*
- 15:20 – 15:30 Úvod do problematiky MOCVD procesů (Pavel Lukašík, Aleš Poruba)
- 15:30 – 16:00 Typické konstrukce MOCVD reaktorů pro „III-V“ polovodiče (Martin Vallo)
- 16:00 – 16:30 Specifika MOCVD přípravy požadovaných vrstev (TiO₂, ZnO, ZrO₂, Fe₂O₃, PZT, HfO₂, BaTiO₃) ve vztahu k jejich požadovaným vlastnostem (Aleš Poruba)
- 16:30 – 17:30 *Diskuse MOCVD procesů*